Symbol	Typ	Titel
G	**Sektion**	**Sektion G — Physik**
G11	**Klasse**	**Informationsspeicherung**
G11C	**Unterklasse**	**Statische Speicher (Halbleiter-Speicherelemente H10B)**
G11C 5/00	**Hauptgruppe**	**Einzelheiten von Speichern, soweit sie von G11C 11/00 umfasst sind [1, 2006.01]**
G11C 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Räumliche Anordnungen von Speicherelementen, z.B. in der Form einer Matrix [1, 2006.01]
G11C 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . Halterungen für Speicherelemente; Anbringen oder Befestigen von Speicherelementen an diesen Halterungen [1, 2006.01]
G11C 5/05	3-Punkt Untergruppe	. . . Halterung der Kerne in der Matrix [2, 2006.01]
G11C 5/06	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zur elektrischen Verbindung von Speicherelementen, z.B. durch Verdrahtung [1, 2006.01]
G11C 5/08	2-Punkt Untergruppe	. . zur gegenseitigen Verbindung von magnetischen Elementen, z.B. von Ringkernen [1, 2006.01]
G11C 5/10	2-Punkt Untergruppe	. . zur gegenseitigen Verbindung von Kondensatoren [1, 2006.01]
G11C 5/12	1-Punkt Untergruppe	. Geräte oder Verfahren zur gegenseitigen Verbindung von Speicherelementen, z.B. zum Einfädeln von Magnetkernen [1, 2006.01]
G11C 5/14	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zur Spannungsversorgung [5, 7, 2006.01]
G11C 7/00	**Hauptgruppe**	**Anordnungen zum Einschreiben oder Auslesen von Informationen in einen bzw. aus einem digitalen Speicher (G11C 5/00 hat Vorrang; Hilfsschaltungen für Halbleiterspeicher G11C 11/4063 , G11C 11/413 , G11C 11/4193) [1, 2, 5, 2006.01]**
G11C 7/02	1-Punkt Untergruppe	. unter Vermeidung von Störsignalen [1, 2006.01]
G11C 7/04	1-Punkt Untergruppe	. unter Vermeidung von Störungen durch Temperatureinflüsse [1, 2006.01]
G11C 7/06	1-Punkt Untergruppe	. Leseverstärker; zugehörige Schaltungen [1, 7, 2006.01]
G11C 7/08	2-Punkt Untergruppe	. . Steuerungen hierfür [7, 2006.01]
G11C 7/10	1-Punkt Untergruppe	. Eingabe/Ausgabe [I/O]-Datenschnittstellenanordnungen, z.B. I/O-Datensteuerungen, I/O-Datenpuffer [7, 2006.01]
G11C 7/12	1-Punkt Untergruppe	. Bitleitungssteuerungen, z.B. Treiber, Verstärker, Pull-up-Schaltungen, Pull-down-Schaltungen, Voraufladungsschaltungen, Entzerrerschaltungen für Bitleitungen [7, 2006.01]
G11C 7/14	1-Punkt Untergruppe	. Dummyzellenverwaltung; Lesevergleichsspannungserzeuger [7, 2006.01]
G11C 7/16	1-Punkt Untergruppe	. Speichern von Analogsignalen in digitalen Speichern unter Verwendung von Anordnungen, die Analog/Digital [A/D]-Wandler, digitale Speicher und Digital/Analog [D/A]-Wandler umfassen [7, 2006.01]
G11C 7/18	1-Punkt Untergruppe	. Organisation der Bitleitungen; Layout der Bitleitungen [7, 2006.01]
G11C 7/20	1-Punkt Untergruppe	. Initialisierungsschaltungen für Speicherzellen, z.B. während des Einschaltens oder Ausschaltens, Löschen des Speichers, latenter Bildspeicher [7, 2006.01]
G11C 7/22	1-Punkt Untergruppe	. Lese-/Schreib [R/W]-Zeitsteuerungsschaltungen oder Taktschaltungen; Erzeugung oder Verwaltung von Lese-/Schreib [R/W]-Steuersignalen [7, 2006.01]
G11C 7/24	1-Punkt Untergruppe	. Sicherheits- oder Schutzschaltungen für Speicherzellen, z.B. Anordnungen zur Verhinderung unbeabsichtigten Lesens oder Schreibens; Statuszellen; Testzellen [7, 2006.01]
G11C 8/00	**Hauptgruppe**	**Anordnungen zur Adressenauswahl für einen digitalen Speicher (für Hilfsschaltungen für Halbleiterspeicher G11C 11/4063 , G11C 11/413 , G11C 11/4193) [2, 5, 2006.01]**
G11C 8/02	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung einer Auswahlmatrix [2, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G11C 8/04	1-Punkt Untergruppe	. mit sequenziell adressierender Einrichtung, z.B. Schieberegister, Zähler [5, 2006.01]
G11C 8/06	1-Punkt Untergruppe	. Adressier-Schnittstellenanordnungen, z.B. Adressenpuffer [7, 2006.01]
G11C 8/08	1-Punkt Untergruppe	. Steuerungsschaltungen für Wortleitungen, z.B. Treiber, Verstärker, Pull-up-Schaltungen, Pull-down-Schaltungen, Voraufladungsschaltungen für Wortleitungen [7, 2006.01]
G11C 8/10	1-Punkt Untergruppe	. Decoder [7, 2006.01]
G11C 8/12	1-Punkt Untergruppe	. Gruppenauswahlschaltungen, z.B. zur Speicherblockauswahl, Chipauswahl, Matrixauswahl [7, 2006.01]
G11C 8/14	1-Punkt Untergruppe	. Organisation der Wortleitungen; Layout der Wortleitungen [7, 2006.01]
G11C 8/16	1-Punkt Untergruppe	. Speichermatrix mit Mehrfachzugriff, z.B. Adressieren eines Speicherelements über mindestens zwei unabhängige Adressleitungsgruppen [7, 2006.01]
G11C 8/18	1-Punkt Untergruppe	. Adressen-Zeitsteuerungs- oder Taktschaltungen; Erzeugung oder Verwaltung von Adressensteuersignalen, z.B. für Zeilenadresstakt-Signale [RAS] oder Spaltenadresstakt-Signale [CAS] [7, 2006.01]
G11C 8/20	1-Punkt Untergruppe	. Sicherheitsschaltungen oder Schutzschaltungen für Adressen, d.h. Anordnungen zur Verhinderung unberechtigter oder unbeabsichtigter Zugriffe [7, 2006.01]
G11C 11/00	**Hauptgruppe**	**Digitale Speicher, gekennzeichnet durch die Verwendung besonderer elektrischer oder magnetischer Speicherelemente; Speicherelemente hierfür (G11C 14/00-G11C 21/00 haben Vorrang) [1, 5, 2006.01]**
G11C 11/02	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen Elementen [1, 2006.01]
G11C 11/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit zylinderförmigen Speicherelementen, z.B. Stab, Draht (G11C 11/12 , G11C 11/14 haben Vorrang) [1, 2, 2006.01]
G11C 11/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Speicherlementen mit einer einzigen Öffnung, z.B. Ringkern; mit Platten mit mehreren Öffnungen, wobei jede einzelne Öffnung ein Speicherelement bildet [1, 2006.01]
G11C 11/061	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Speicherelementen mit einer einzigen Öffnung oder mit einem Magnetkreis, wobei ein Element pro Bit verwendet und wobei beim Auslesen gelöscht wird [2, 2006.01]
G11C 11/063	4-Punkt Untergruppe	. . . . bit-organisiert, z.B. 2L/2D-Organisation oder dreidimensionale [3D]-Organisation, d.h. organisiert zur Auswahl eines Elements mit wenigstens zwei koinzidenten Teilströmen sowohl zum Auslesen als auch zum Einschreiben [2, 2006.01]
G11C 11/065	4-Punkt Untergruppe	. . . . wort-organisiert, z.B. mit zweidimensionaler [2D]-Organisation oder lineare Auswahl, d.h. organisiert zur Auswahl aller Elemente eines Wortes mittels eines einzigen Vollstroms beim Auslesen [2, 2006.01]
G11C 11/067	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Speicherelementen mit einer einzigen Öffnung oder mit einem Magnetkreis, wobei ein Element pro Bit verwendet und wobei beim Auslesen nicht gelöscht wird [2, 2006.01]
G11C 11/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Speicherelementen mit mehreren Öffnungen, z.B. Transfluxoren; mit Platten, die verschiedene, jeweils mit mehreren Öffnungen versehene Speicherelemente bilden (G11C 11/10 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01]
G11C 11/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit mehraxialen Speicherelementen [1, 2006.01]
G11C 11/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit Tensoren; mit Twistoren, d.h. mit Elementen, in denen eine Achse der Magnetisierung gedreht ist [1, 2006.01]
G11C 11/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit Dünnschichtelementen [1, 2006.01]
G11C 11/15	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehreren magnetischen Schichten (G11C 11/155 hat Vorrang) [2, 2006.01]
G11C 11/155	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zylindrischer Konfiguration [2, 2006.01]
G11C 11/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit Elementen, in denen der Speichereffekt auf dem magnetischen Spineffekt beruht [1, 2006.01]
G11C 11/18	1-Punkt Untergruppe	. mit Halleffekt-Elementen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G11C 11/19	1-Punkt Untergruppe	. mit nichtlinearen Reaktanzen in Resonanzkreisen [2, 2006.01]
G11C 11/20	2-Punkt Untergruppe	. . mit Parametrons [1, 2, 2006.01]
G11C 11/21	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischen Elementen [2, 2006.01]
G11C 11/22	2-Punkt Untergruppe	. . mit ferroelektrischen Elementen [1, 2, 2006.01]
G11C 11/23	2-Punkt Untergruppe	. . mit elektrostatischer Speicherung auf einer gemeinsamen Schicht, z.B. Forrester-Haeff-Röhren (G11C 11/22 hat Vorrang) [2, 2006.01]
G11C 11/24	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kondensatoren (G11C 11/22 hat Vorrang; in Kombination mit Halbleitern und Kondensatoren G11C 11/34 , z.B. G11C 11/40) [1, 2, 5, 2006.01]
G11C 11/26	2-Punkt Untergruppe	. . mit Entladungsröhren [1, 2, 2006.01]
G11C 11/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mit gasgefüllten Röhren [1, 2, 2006.01]
G11C 11/30	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Hochvakuumröhren (G11C 11/23 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01]
G11C 11/34	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleitern [1, 2, 2006.01]
G11C 11/35	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Ladungsspeicherung in einer Verarmungsschicht, z.B. ladungsgekoppelte Bauelemente [Charge Coupled Devices = CCD] [7, 2006.01]
G11C 11/36	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Dioden, z.B. als Schwellwertelemente [1, 2, 2006.01]
G11C 11/38	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit Tunneldioden [1, 2, 2006.01]
G11C 11/39	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Thyristoren [5, 2006.01]
G11C 11/40	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Transistoren [1, 2, 2006.01]
G11C 11/401	4-Punkt Untergruppe	. . . . bestehend aus Zellen, die eine Auffrischung oder Ladungsregeneration benötigen, d.h. dynamische Zellen [5, 2006.01]
G11C 11/402	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit Ladungsregeneration für jede einzelne Speicherzelle, d.h. interne Auffrischung [5, 2006.01]
G11C 11/403	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit gemeinsamer Ladungsregeneration für mehrere Speicherzellen, d.h. externe Auffrischung [5, 2006.01]
G11C 11/404	6-Punkt Untergruppe	. . . . . mit einer Ladungstransferstrecke pro Zelle, z.B. MOS-Transistor [5, 2006.01]
G11C 11/405	6-Punkt Untergruppe	. . . . . mit drei Ladungstransferstrecken pro Zelle, z.B. MOS- Transistoren [5, 2006.01]
G11C 11/406	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Überwachung oder Regelung der Auffrischzyklus oder Ladungsregenerationszyklen [5, 2006.01]
G11C 11/4063	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Hilfsschaltungen, z.B. zum Adressieren, Decodieren, Treiben, Schreiben, Abtasten oder zur Zeitsteuerung [7, 2006.01]
G11C 11/4067	6-Punkt Untergruppe	. . . . . für bipolare Speicherzellen [7, 2006.01]
G11C 11/407	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Zusatzschaltungen für Feldeffektspeicherzellen [5, 2006.01]
G11C 11/4072	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Schaltungen zum Initialisieren, zum Einschalten, zum Abschalten in den Ruhezustand, zum Löschen des Speichers oder zum Voreinstellen [7, 2006.01]
G11C 11/4074	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Schaltungen zur Stromversorgung oder zur Spannungserzeugung, z.B. Vorspannungserzeuger, Substratspannungserzeuger, Reservestromversorgung, Stromversorgungssteuerung [7, 2006.01]
G11C 11/4076	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Zeitsteuerungen (zur Überwachung der Regeneration G11C 11/406) [7, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G11C 11/4078	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Sicherheitsschaltungen oder Schutzschaltungen, z.B. zum Verhindern des versehentlichen oder unberechtigten Lesens oder Schreibens; Zustandszellen; Prüfzellen (Schutz des Speicherinhalts während des Prüfens oder Testens G11C 29/52) [7, 2006.01]
G11C 11/408	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Adressierschaltungen [5, 2006.01]
G11C 11/409	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Lese-/Schreib[R/W]-Schaltungen [5, 2006.01]
G11C 11/4091	8-Punkt Untergruppe	. . . . . Abtast- oder Abtast/Refresh-Verstärker oder verwandte Abtastschaltungen, z.B. gekoppeltes Vorladen, Ausgleichen oder Isolieren der Bitleitungen [7, 2006.01]
G11C 11/4093	8-Punkt Untergruppe	. . . . . Anordnungen für Dateneingabe-/Datenausgabe[I/O]-Schnittstellen, z.B. Datenpuffer [7, 2006.01]
G11C 11/4094	8-Punkt Untergruppe	. . . . . Schaltungen zur Verwaltung oder Steuerung der Bitleitungen [7, 2006.01]
G11C 11/4096	8-Punkt Untergruppe	. . . . . Schaltungen zur Verwaltung oder Steuerung der Dateneingabe/-ausgabe [I/O], z.B. Lese- oder Schreibschaltungen, I/O-Treiber, Bitleitungsschalter [7, 2006.01]
G11C 11/4097	8-Punkt Untergruppe	. . . . . Bitleitungsorganisation, z. B. bit-line layout, folded bit-lines [7, 2006.01]
G11C 11/4099	8-Punkt Untergruppe	. . . . . Behandlung von Leerzellen; Referenzspannungserzeuger [7, 2006.01]
G11C 11/41	4-Punkt Untergruppe	. . . . bestehend aus Zellen mit positiver Rückkopplung, d.h. Zellen, die keine Auffrischung oder Ladungsregeneration benötigen, z.B. bistabiler Multivibrator oder Schmitt-Trigger [5, 2006.01]
G11C 11/411	5-Punkt Untergruppe	. . . . . nur mit Bipolartransistoren [5, 2006.01]
G11C 11/412	5-Punkt Untergruppe	. . . . . nur mit Feldeffekttransistoren [5, 2006.01]
G11C 11/413	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Zusatzschaltungen, z.B. zum Adressieren, Decodieren, Treiben, Schreiben, Abtasten, zur Zeitsteuerung oder Leistungsreduzierung [5, 2006.01]
G11C 11/414	6-Punkt Untergruppe	. . . . . für bipolare Speicherzellen [5, 2006.01]
G11C 11/415	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Adressierschaltungen [5, 2006.01]
G11C 11/416	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Lese-/Schreib[R/W]-Schaltungen [5, 2006.01]
G11C 11/417	6-Punkt Untergruppe	. . . . . für Feldeffekt-Speicherzellen [5, 2006.01]
G11C 11/418	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Adressierschaltungen [5, 2006.01]
G11C 11/419	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Lese-/Schreib[R/W]-Schaltungen [5, 2006.01]
G11C 11/4193	3-Punkt Untergruppe	. . . für spezielle Halbleiterspeicherbauelemente typische Hilfsschaltungen, z.B. zum Adressieren, Treiben, Abtasten, zur Zeitsteuerung, Stromversorgung, Signalausbreitung (G11C 11/4063 , G11C 11/413 haben Vorrang) [7, 2006.01]
G11C 11/4195	4-Punkt Untergruppe	. . . . Adressierschaltungen [7, 2006.01]
G11C 11/4197	4-Punkt Untergruppe	. . . . Schreib-/Lese[R/W]-Schaltungen [7, 2006.01]
G11C 11/42	2-Punkt Untergruppe	. . mit optoelektrischen Bauelementen, d.h. elektrisch oder optisch gekoppelten lichtemittierenden und fotoelektrischen Bauelementen [1, 2006.01]
G11C 11/44	2-Punkt Untergruppe	. . mit supraleitfähigen Elementen, z.B. Kryotron [1, 2, 2006.01]
G11C 11/46	1-Punkt Untergruppe	. mit thermoplastischen Elementen [1, 2006.01]
G11C 11/48	1-Punkt Untergruppe	. mit verschiebbaren Koppelelementen, z.B. mit ferromagnetischen Kernen, zum Kippen zwischen verschiedenen Zuständen einer induktiven Kopplung oder Selbstinduktion [1, 2006.01]
G11C 11/50	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischen Kontakten zur Speicherung von Informationen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G11C 11/52	2-Punkt Untergruppe	. . mit elektromagnetischen Relais [1, 2006.01]
G11C 11/54	1-Punkt Untergruppe	. mit Elementen zur Simulierung von biologischen Zellen, z.B. Neuronen [1, 2006.01]
G11C 11/56	1-Punkt Untergruppe	. mit Speicherelementen mit mehr als zwei stabilen Zuständen, die durch Stufen, z.B. von Spannung, Strom, Phase, Frequenz repräsentiert sind [2, 2006.01]
G11C 13/00	**Hauptgruppe**	**Digitale Speicher, gekennzeichnet durch die Verwendung von Speicherelementen, soweit sie nicht von den Gruppen G11C 11/00 , G11C 23/00 oder G11C 25/00 umfasst sind [1, 2006.01]**
G11C 13/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Elementen, deren Wirkungsweise auf chemischen Änderungen beruht [1, 2006.01]
G11C 13/04	1-Punkt Untergruppe	. mit optischen Elementen [1, 2006.01]
G11C 13/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit magnetooptischen Elementen [2, 2006.01]
G11C 14/00	**Hauptgruppe**	**Digitale Speicher, gekennzeichnet durch Speicherzellenanordnungen mit flüchtigem und nichtflüchtigem Speicherverhalten zum Informationserhalt bei ausgefallener Spannung [5, 2006.01]**
G11C 15/00	**Hauptgruppe**	**Digitale Speicher, in denen eine mit einem oder mehreren charakteristischen Teilen versehene Information eingeschrieben und dadurch ausgelesen wird, dass der oder die charakteristischen Teile aufgesucht werden, d.h. assoziative oder inhaltsadressierte Speicher [1, 2, 2006.01]**
G11C 15/02	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen Elementen [2, 2006.01]
G11C 15/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Halbleiterelementen [2, 2006.01]
G11C 15/06	1-Punkt Untergruppe	. mit supraleitfähigen Elementen, z.B. Kryotrons [2, 2006.01]
G11C 16/00	**Hauptgruppe**	**Löschbare, programmierbare Festwertspeicher (G11C 14/00 hat Vorrang) [5, 2006.01]**
G11C 16/02	1-Punkt Untergruppe	. elektrisch programmierbar [5, 2006.01]
G11C 16/04	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Transistoren mit variablem Schwellenwert, z.B. FAMOS [5, 2006.01]
G11C 16/06	2-Punkt Untergruppe	. . Hilfsschaltungen, z.B. für Schreiben in den Speicher [5, 2006.01]
G11C 16/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Adressierschaltungen; Decoder; Steuerschaltungen für Wortleitungen [7, 2006.01]
G11C 16/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Programmierschaltungen oder Dateneingabeschaltungen [7, 2006.01]
G11C 16/12	4-Punkt Untergruppe	. . . . Programmierspannungsschaltungen [7, 2006.01]
G11C 16/14	4-Punkt Untergruppe	. . . . elektrische Löschschaltungen, z.B. Löschspannungsschaltungen [7, 2006.01]
G11C 16/16	5-Punkt Untergruppe	. . . . . zum Löschen von Blöcken, z.B. Arrays, Wörter, Gruppen [7, 2006.01]
G11C 16/18	4-Punkt Untergruppe	. . . . Optische Löschschaltungen [7, 2006.01]
G11C 16/20	4-Punkt Untergruppe	. . . . Initialisierung; Datenvoreinstellung; Chipidentifizierung [7, 2006.01]
G11C 16/22	3-Punkt Untergruppe	. . . Sicherheitsschaltungen oder Schutzschaltungen zur Verhinderung des unerlaubten oder zufälligen Zugriffs auf Speicherzellen [7, 2006.01]
G11C 16/24	3-Punkt Untergruppe	. . . Bitleitungskontrollschaltungen [7, 2006.01]
G11C 16/26	3-Punkt Untergruppe	. . . Abtastschaltungen oder Leseschaltungen; Datenausgabeschaltungen [7, 2006.01]
G11C 16/28	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit differenzieller Abtastung oder mit Referenzzellen, z.B. Leerzellen [7, 2006.01]
G11C 16/30	3-Punkt Untergruppe	. . . Spannungsversorgungsschaltungen [7, 2006.01]
G11C 16/32	3-Punkt Untergruppe	. . . Zeitgeberschaltungen [7, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G11C 16/34	3-Punkt Untergruppe	. . . Ermitteln des Programmierzustands, z.B. Schwellenspannung, Überprogrammierung oder Unterprogrammierung, Datenhaltung [7, 2006.01]
G11C 17/00	**Hauptgruppe**	**Nur einmal programmierbare Festwertspeicher; Halbfestwertspeicher, z.B. mit manuell auswechselbaren Informationsträgerkarten [1, 2, 5, 2006.01]**
G11C 17/02	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen oder induktiven Elementen oder mit magnetischer oder induktiver Kopplung (G11C 17/14 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01]
G11C 17/04	1-Punkt Untergruppe	. mit kapazitiven Elementen oder kapazitiver Kopplung (G11C 17/06 , G11C 17/14 haben Vorrang) [2, 5, 2006.01]
G11C 17/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Dioden oder mit Dioden-Kopplung (G11C 17/14 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01]
G11C 17/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Halbleiterbauelementen, z.B. bipolaren Bauelementen (G11C 17/06 , G11C 17/14 haben Vorrang) [5, 2006.01]
G11C 17/10	2-Punkt Untergruppe	. . in denen der Speicherinhalt während des Herstellungsvorgangs durch eine vorher festgelegte Anordnung von Koppelelementen bestimmt wird, z.B. maskenprogrammierbarer Festwertspeicher [ROM] [5, 2006.01]
G11C 17/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Feldeffekt-Bauelementen [5, 2006.01]
G11C 17/14	1-Punkt Untergruppe	. in denen der Speicherinhalt durch selektives Herstellen, Unterbrechen oder Ändern von Verbindungsstellen durch bleibende Änderung des Zustands von Koppelelementen bestimmt wird, z.B. PROM [5, 2006.01]
G11C 17/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit Koppelelementen, die die Funktion einer elektrischen Sicherung aufweisen [5, 2006.01]
G11C 17/18	2-Punkt Untergruppe	. . Hilfsschaltungen, z.B. für Schreiben in den Speicher [5, 2006.01]
G11C 19/00	**Hauptgruppe**	**Digitale Speicher, in denen die Information schrittweise bewegt wird, z.B. Schieberegister [1, 2006.01]**
G11C 19/02	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen Elementen (G11C 19/14 hat Vorrang) [2, 2006.01]
G11C 19/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kernen mit einer Öffnung oder einem Magnetkreis [2, 2006.01]
G11C 19/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit mehreren Öffnungen oder Magnetkreisen, z.B. Transfluxoren [2, 2006.01]
G11C 19/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit dünnen Filmen in ebener Anordnung [2, 2006.01]
G11C 19/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit dünnen Filmen auf Stäben; mit Twistoren [2, 2006.01]
G11C 19/12	1-Punkt Untergruppe	. mit nichtlinearen Reaktanzen in Resonanzkreisen [2, 2006.01]
G11C 19/14	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen Elementen in Kombination mit aktiven Elementen, z.B. mit Entladungsröhren, mit Halbleiterbauelementen (G11C 19/34 hat Vorrang) [2, 7, 2006.01]
G11C 19/18	1-Punkt Untergruppe	. mit Kondensatoren als Hauptelemente der Stufen [2, 2006.01]
G11C 19/20	1-Punkt Untergruppe	. mit Entladungsröhren (G11C 19/14 hat Vorrang) [2, 2006.01]
G11C 19/28	1-Punkt Untergruppe	. mit Halbleiterbauelementen (G11C 19/14 , G11C 19/36 haben Vorrang) [2, 7, 2006.01]
G11C 19/30	1-Punkt Untergruppe	. mit optoelektronischen Anordnungen, d.h. lichtemittierenden und fotoelektrischen Anordnungen, die elektrisch oder optisch gekoppelt sind [2, 2006.01]
G11C 19/32	1-Punkt Untergruppe	. mit supraleitenden Elementen [2, 2006.01]
G11C 19/34	1-Punkt Untergruppe	. mit Speicherelementen, die mehr als zwei stabile, durch Stufen verkörperte Zustände aufweisen, z.B. Spannung, Strom, Phase, Frequenz [7, 2006.01]
G11C 19/36	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleiterbauelementen [7, 2006.01]
G11C 19/38	1-Punkt Untergruppe	. zweidimensional [2D], z.B. horizontale und vertikale Schieberegister [7, 2006.01]
G11C 21/00	**Hauptgruppe**	**Digitale Speicher, in denen die Information zirkuliert (schrittweise G11C 19/00) [1, 2006.01]**

Symbol	Typ	Titel
G11C 21/02	1-Punkt Untergruppe	. mit elektromechanischen Verzögerungsleitungen, z.B. mit Quecksilber-Behälter [1, 2006.01]
G11C 23/00	**Hauptgruppe**	**Digitale Speicher, gekennzeichnet durch die Bewegung mechanischer Teile zur Herstellung eines Speichereffektes, z.B. Kugeln; Speicherelemente hierfür [1, 2006.01]**
G11C 25/00	**Hauptgruppe**	**Digitale Speicher, gekennzeichnet durch die Verwendung fließfähiger Medien; Speicherelemente hierfür [1, 2006.01]**
G11C 27/00	**Hauptgruppe**	**Elektrische Analogspeicher, z.B. zur Speicherung von Augenblickswerten [1, 2006.01]**
G11C 27/02	1-Punkt Untergruppe	. Abtast- und Speicheranordnungen (G11C 27/04 hat Vorrang) [2, 4, 2006.01]
G11C 27/04	1-Punkt Untergruppe	. Schieberegister [4, 2006.01]
G11C 29/00	**Hauptgruppe**	**Prüfen von Speichern auf richtige Arbeitsweise; Testen von Speichern während des Standby- oder Offline-Betriebs [1, 2006.01]**
G11C 29/02	1-Punkt Untergruppe	. Ermitteln oder Lokalisieren defekter Hilfsschaltungen, z.B. defekter Refresh- Zähler [2006.01]
G11C 29/04	1-Punkt Untergruppe	. Ermitteln oder Lokalisieren defekter Speicherelemente [2006.01]
G11C 29/06	2-Punkt Untergruppe	. . zeitraffende Prüfung [2006.01]
G11C 29/08	2-Punkt Untergruppe	. . Funktionsprüfung, z.B. Prüfung während einer Auffrischung, Einschalt-Selbsttest (power- on self testing [POST]) oder verteilter Prüfung [2006.01]
G11C 29/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Prüfalgorithmen, z.B. Speicher-Scan-Algorithmen [MScan]; Prüfmuster, z.B. Schachbrettmuster [2006.01]
G11C 29/12	3-Punkt Untergruppe	. . . eingebaute Prüfanordnungen, z.B. eingebauter Selbsttest [BIST] [2006.01]
G11C 29/14	4-Punkt Untergruppe	. . . . Implementierung von Steuerlogik, z.B. Testmodusdecoder [2006.01]
G11C 29/16	5-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung mikroprogrammierter Einheiten, z.B. Zustandsmaschinen [2006.01]
G11C 29/18	4-Punkt Untergruppe	. . . . Adressengeneratoren; Einrichtungen für Speicherzugriff, z.B. Einzelheiten von Adressierschaltungen [2006.01]
G11C 29/20	5-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Zählern oder Schieberegistern mit linearer Rückkopplung [LFSR] [2006.01]
G11C 29/22	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Zugriff auf serielle Speicher [2006.01]
G11C 29/24	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Zugriff auf Zusatzzellen, z.B. Dummy-Zellen oder redundante Zellen [2006.01]
G11C 29/26	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Zugriff auf Mehrfach-Arrays (G11C 29/24 hat Vorrang) [2006.01]
G11C 29/28	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Abhängige Mehrfach-Arrays, z.B. Multibit-Arrays [2006.01]
G11C 29/30	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Zugriff auf Einfach-Arrays [2006.01]
G11C 29/32	6-Punkt Untergruppe	. . . . . serieller Zugriff; Scan- Test [2006.01]
G11C 29/34	6-Punkt Untergruppe	. . . . . simultaner Zugriff auf mehrere Bits [2006.01]
G11C 29/36	4-Punkt Untergruppe	. . . . Bauelemente zur Datenerzeugung, z.B. Dateninverter [2006.01]
G11C 29/38	4-Punkt Untergruppe	. . . . Bauelemente zur Überprüfung der Antwort [2006.01]
G11C 29/40	5-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Kompressionstechniken [2006.01]
G11C 29/42	5-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Fehlerkorrekturcodes [ECC] oder Paritätsprüfung [2006.01]
G11C 29/44	4-Punkt Untergruppe	. . . . Anzeige oder Feststellung von Fehlern, z.B. zur Reparatur [2006.01]
G11C 29/46	4-Punkt Untergruppe	. . . . Testauslöselogik [2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G11C 29/48	3-Punkt Untergruppe	. . . Anordnungen in statischen Speichern speziell angepasst an die Prüfung mit Mitteln außerhalb des Speichers, z.B. unter Verwendung von direktem Speicherzugriff [DMA] oder unter Verwendung externer Zugriffspfade [2006.01]
G11C 29/50	2-Punkt Untergruppe	. . Grenzwertprüfung, z.B. Race, Spannungsprüfung oder Stromprüfung [2006.01]
G11C 29/52	1-Punkt Untergruppe	. Schutz von Speicherinhalten; Fehlererkennung in Speicherinhalten [2006.01]
G11C 29/54	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Entwurf von Testschaltungen, z.B. design for test [DFT] tools [2006.01]
G11C 29/56	1-Punkt Untergruppe	. externe Prüfsysteme für statische Speicher, z.B. automatische Testsysteme [ATE]; Schnittstellen hierfür [2006.01]
G11C 99/00	**Hauptgruppe**	**Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01]**